

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

Written Opinion of
International
Searching Authority

出願人代理人

河宮 浩

様

あて名

〒 540-0001

大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号IMPビル
青山特許事務所PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]発送日
(日.月.年)

15. 2. 2005

出願人又は代理人
の書類記号 664801

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2004/016029

国際出願日
(日.月.年)

28. 10. 2004

優先日

(日.月.年)

31. 10. 2003

国際特許分類 (IPC)

Int.Cl⁷. G06F12/00, G06K19/07

出願人 (氏名又は名称)

松下電器産業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

27.01.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JPT)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
多賀 実

5N 9367

電話番号 03-3581-1101 内線 3584

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

外国方式

第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見:

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-23	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	10-13, 17, 23	有
	請求の範囲	1-9, 14-16, 18-22	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-23	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

- 文献1: JP 2000-181784 A (株式会社日立製作所)
2000.06.30, 全文, 全図
文献2: JP 10-283230 A (日本電気株式会社)
1998.10.23, 全文 (特に段落【0058】), 全図
文献3: JP 11-39210 A (カシオ計算機株式会社)
1999.02.12, 段落【0042】-【0058】, 図4, 5
文献4: JP 10-307749 A (いわき電子株式会社)
1998.11.17, 全文, 全図
文献5: JP 6-52691 A (株式会社東芝)
1994.02.25, 段落【0035】-【0044】, 全図
文献6: JP 4-263386 A (富士写真フイルム株式会社)
1992.09.18, 全文, 全図

文献1には、ホスト処理装置から書き込まれるデータを記憶する記憶装置であつて、1セクタサイズで書き換え可能な第1のデータ格納ブロックと、4セクタサイズで書き換え可能な第2のデータ格納ブロックとを有し、ホスト処理装置が指示する書き込みデータのサイズが1セクタサイズか否か (あるいは命令コード) に応じて、第1及び第2のデータ格納ブロックのいずれか一方に書き込みデータを格納する記憶装置が記載されている。さらに、

- 1) FAT領域やルートディレクトリ領域のデータは1セクタサイズで書き換えられ、通常データ領域は4セクタを1クラスタとする単位でアクセスされることが多いこと (第【0082】、【0088】段落)、
- 2) 第1及び第2のデータ格納ブロックは、それぞれ別々の不揮発性半導体メモリに設けても、1つの不揮発性メモリに混在させて設けてもよいこと (第【0029】段落)、
- 3) 論理物理アドレス変換テーブルを備えることが記載されている。

文献2には、二次記憶装置上の記憶領域を複数のサイズのブロックに仕切るとともにサイズ別の領域管理情報を作成し、書き込もうとしているデータの種類のについての通知に基づき、どのブロックサイズを使用するか決めることが記載されている。データの種類としては、利用者が書き込みを要求したデータと、ファイルの管理情報とがあることが記載されている (第【0058】段落)。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

文献3には、ブロック毎で異なるセクタ長で管理されるよう構成されたフラッシュメモリに対して、データ種別の通知に応じて、書き込み対象とするブロックを決定することが記載されている。

文献4には、書き換え可能回数が極めて多い強誘電体メモリに管理情報（いわゆるFAT）を、フラッシュメモリにデータを格納するメモリ装置が記載されている。

文献5には、フラッシュEEPROMを備えた半導体ディスク装置において、第1の書き込み単位を有する第1のフラッシュEEPROMチップ、および前記第1の書き込み単位よりも小さい第2の書き込み単位を有する第2のフラッシュEEPROMチップを有し、

ユーザデータが前記第1のフラッシュEEPROMチップに書き込まれ、そのユーザデータの格納位置を管理するための管理情報が第2のフラッシュEEPROMチップに書き込まれるように、書き込みデータの種類のに応じてライトアクセス対象のフラッシュEEPROMチップを切り替えること、が記載されている。書き込みデータの種類の判別は、具体的にはアドレスにより行われている。

文献6には、文献5と同様の発明が記載されている。

（請求の範囲1-7, 14-16, 18-22）

文献1-3により進歩性を有しない。文献1記載の記憶装置において、文献2, 3記載の発明と同様に、通知されたデータ種別に応じてデータ格納ブロックを選択するとともに、文献2記載の発明に基づき、第2のデータ格納ブロックを4セクタサイズ単位で管理するよう構成することは、当業者にとって自明である。

（請求の範囲8）

文献1-4により進歩性を有しない。文献1記載の記憶装置において、第1及び第2のデータ格納ブロックの寿命特性を異なるものとすることは、文献4記載の発明に基づき容易に想到されることである。

（請求の範囲9）

文献1-3, 5, 6により進歩性を有しない。データ種別をデータの書き込み位置に基づいて判断することは、文献5, 6記載の発明に基づき容易に想到されることである。

（請求の範囲10-13, 17, 23）

新規性、進歩性を有する。ファイルシステム管理情報の位置や大きさに関する情報を外部より受信し、レジスタに保持して、データ種別、さらには、第1及び第2の記録領域のいずれに書き込むべきかの判断に用いることは、いずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明でもない。